



**2N3906: Transistor PNP Silicon Planar  
Epitaxial 40V 0.2A**



# Descripción

**Nombre:** TRANSISTOR PNP SILICON PLANAR EPITAXIAL Transistor PNP de propósito general.  
**Referencia:** 2N3906

- Polaridad del transistor: PNP
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 200mA
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 40V
- Voltaje VCBO colector-base: 40V
- Voltaje VEBO emisor-base: 5V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 0.25V
- Dp - Disipación de potencia: 1.5W
- Producto para ganar Ancho de banda fT: 250 MHz
- Temperatura de trabajo: desde -55°C hasta 150°C

**Marca:** MOTOROLA **Empaque:** TO-92 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [2N3906](#)

## Información del producto

**Descripción:** TRANSISTOR PNP SILICON PLANAR EPITAXIAL. Marca: MOTOROLA. Referencia: 2N3906 El 2N3906 es un transistor de unión bipolar (BJT) PNP de baja señal, comúnmente utilizado en aplicaciones de amplificación y conmutación. El 2N3906 tiene equivalentes de otros fabricantes, como el BC557 o el [NTE159](#).

**Precio:** \$854 IVA INCLUIDO

**SKU:** 9-5-169

**Categorías:** [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

**Etiquetas:** [0090005000169](#), [2N3906](#), [9-5-169](#), [datasheet](#), [MOTOROLA](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR PNP SILICON PLANAR EPITAXIAL](#),



MOTOROLA SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA

General Purpose Transistors  
PNP Silicon

2N3906  
2N3906\*

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage (IC = 0, IB = 0)	VCEO	40	V
Collector-Base Voltage (IE = 0, IC = 0)	VCBO	40	V
Emitter-Base Voltage (IC = 0, IE = 0)	VEBO	5	V
Collector Current (DC) (Tc = 25°C)	IC	200	mA
Collector Current (Pulse) (Tc = 25°C)	ICM	600	mA
Base Current (DC) (Tc = 25°C)	IB	20	mA
Base Current (Pulse) (Tc = 25°C)	IBM	60	mA
Power Dissipation (Tc = 25°C)	PD	1.5	W
Storage Temperature Range	Tstg	-55 to 150	°C
Operating Temperature Range	TO	-55 to 150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tc = 25°C unless otherwise specified)

Characteristic	Symbol	Min.	Max.	Unit
DC Current Gain (hFE) (IC = 10 mA, IB = 1 mA)	hFE	100	300	
DC Current Gain (hFE) (IC = 100 mA, IB = 10 mA)	hFE	20	100	
Common-Emitter Voltage Gain (VCE = 10 V, IC = 10 mA, RE = 100 Ω)	AV	100	300	
Common-Emitter Voltage Gain (VCE = 10 V, IC = 100 mA, RE = 100 Ω)	AV	20	100	
Common-Emitter Output Resistance (VCE = 10 V, IC = 10 mA, RE = 100 Ω)	RO	—	100	Ω
Common-Emitter Output Resistance (VCE = 10 V, IC = 100 mA, RE = 100 Ω)	RO	—	100	Ω
Common-Emitter Input Resistance (VCE = 10 V, IC = 10 mA, RE = 100 Ω)	RI	—	100	Ω
Common-Emitter Input Resistance (VCE = 10 V, IC = 100 mA, RE = 100 Ω)	RI	—	100	Ω
Common-Emitter Transition Frequency (VCE = 10 V, IC = 10 mA, RE = 100 Ω)	fT	250	—	MHz
Common-Emitter Transition Frequency (VCE = 10 V, IC = 100 mA, RE = 100 Ω)	fT	250	—	MHz
Common-Emitter Delay Time (VCE = 10 V, IC = 10 mA, RE = 100 Ω)	tD	—	100	ns
Common-Emitter Delay Time (VCE = 10 V, IC = 100 mA, RE = 100 Ω)	tD	—	100	ns
Common-Emitter Rise Time (VCE = 10 V, IC = 10 mA, RE = 100 Ω)	tR	—	100	ns
Common-Emitter Rise Time (VCE = 10 V, IC = 100 mA, RE = 100 Ω)	tR	—	100	ns
Common-Emitter Fall Time (VCE = 10 V, IC = 10 mA, RE = 100 Ω)	tF	—	100	ns
Common-Emitter Fall Time (VCE = 10 V, IC = 100 mA, RE = 100 Ω)	tF	—	100	ns

MOT

MOTOROLA